PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-087248

(43) Date of publication of application: 30.03.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/205

(21)Application number: 09-237459

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

02.09.1997

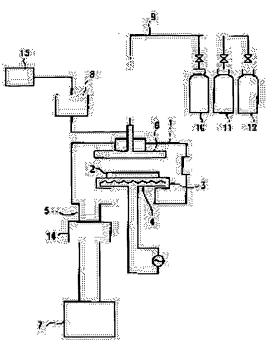
(72)Inventor: YAGI NAOMI

(54) PLASMA-CLEANING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To decide accurately the time of the end of a plasma-cleaning treatment, without depending on an experience or a perception by a method wherein the number of fine grains and particles being contained in exhaust gas is measured and, when the measured values of these fine grains and particles is converged to a prescribed value, the operation of the plasma cleaning treatment is stopped at the time of the convergence.

SOLUTION: Radicals or ions given high energy with the start of a plasma- cleaning treatment are made to react with a shower electrode 6 and an undesired attachment on the surface of a susceptor 3 and are gasified and, at the same time, particles are generated. These particles are exhausted through an exhaust piping 5 by the flow of gas in a chamber 1, but the number of the particles is counted by a particle counter 14 mounted in the middle of the exhaust. In this way, if changes in the counted number of the particles are monitored and the counted



number decreases to the first level (two counts each second), the time at this decrease is set to be the time of the end of the cleaning treatment, and an RF power supply 8 is turned off.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-87248

(43)公開日 平成11年(1999) 3月30日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

HO1L 21/205

H01L 21/205

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平9-237459

(22)出願日

平成9年(1997)9月2日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 八木 有百実

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

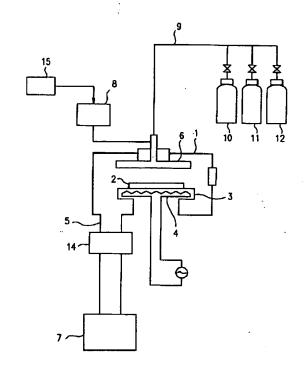
(74)代理人 弁理士 山本 秀策

(54) 【発明の名称】 プラズマクリーニング装置

(57)【要約】

【課題】 経験や勘に頼ることなく、プラズマクリーニング処理の終了時点を正確に判定することができるプラズマクリーニング装置を提供する。

【解決手段】 ブラズマCVD装置のチャンバ1の排気系5にパーティクルカウンタ14を取り付け、ブラズマクリーニング処理中の排気パーティクルをモニタし、パーティクルカウンタ14のカウント数が所定の値まで減少した時点をブラズマクリーニング処理の終了時点と判定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラズマCVD装置の真空状態にあるチ ャンパ内にクリーニング用のガスを導入し、続いて、該 ガスをプラズマ状態にし、該チャンバの内壁及び該チャ ンバ内の構造物に付着した不要付着物と反応させ、反応 物をガス化して該チャンパから排気することによりプラ ズマCVD装置のクリーニングを行うプラズマクリーニ ング装置であって、

反応物をガス化してなる排気ガスを該チャンバから排気 する排気系にパーティクル計数手段を設け、ブラズマク 10 リーニング時において、該パーティクル計数手段により 該排気ガス中に含まれる微粒子パーティクルの数を計測 し、計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズ マクリーニング助作を停止させるように構成したプラズ マクリーニング装置。

【請求項2】 前記チャンバ内の圧力を定期的に計測す ることにより、該チャンバ内の圧力変化を検出する圧力 変化検出手段を更に備え、プラズマクリーニング時の該 チャンパ内の圧力が一定となり、且つ前記パーティクル 計数手段の計測値が所定の値に収束すると、その時点で 20 プラズマクリーニング動作を停止させるように構成した 請求項1記載のプラズマクリーニング装置。

【請求項3】 前記チャンバのビューボート等に設けた 発光スペクトル分析器を更に備え、プラズマクリーニン グ時に該発光スペクトル分析器により発光スペクトル強 度を計測し、該発光スペクトル強度が所定の値に収束 し、且つ前記パーティクル計数手段の計測値が所定の値 に収束すると、その時点でプラズマクリーニング助作を 停止させるように構成した請求項1記載のプラズマクリ ーニング装置。

【請求項4】 前記圧力変化検出手段により検出される 圧力変化量の時間積分値及び前記パーティクル計数手段 により計測されるパーティクル変化量の時間積分値を求 め、更にとれらの時間積分値に所定の係数を乗ずる演算 手段を備え、これらの時間積分値に所定の係数を乗じた 値の合算値が所定の値になると、その時点でプラズマク リーニング動作を停止させるように構成した請求項2記 載のプラズマクリーニング装置。

【請求項5】 前記発光スペクトル分析器により検出さ れる発光スペクトル強度の時間積分値及び前記パーティ クル計数手段により計測されるパーティクル変化量の時 間積分値を求め、更にとれらの時間積分値に所定の係数 を乗ずる演算手段を備え、これらの時間積分値に所定の 係数を乗じた値の合算値が所定の値になると、その時点 でプラズマクリーニング動作を停止させるように構成し た請求項3記載のプラズマクリーニング装置。

【請求項6】 前記排気系は前記チャンバの底面排気口 から真下に真っ直ぐに伸ばした排気配管を有し、該排気 配管の途中であって、該チャンバの底面から10~10 0mm離反した位置に前記パーティクル計数手段のセン 50 がある。

サ部を取り付けた請求項1~請求項5のいずれかに記載 のプラズマクリーニング装置。

【請求項7】 前記プラズマCVD装置の成膜時に前記 パーティクル計数手段のセンサ部を50~200℃に加 熱するようにした請求項1~請求項6のいずれかに記載 のプラズマクリーニング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマCVD (Chemical Vapor Depositio n) 法によってIC, LSI等に用いられるSiウェハ 上に薄膜を形成するプラズマCVD装置に搭載されるプ ラズマクリーニング装置に関し、より詳しくは、ブラズ マCVD装置のチャンバ内壁等に付着した不要付着物を 除去するプラズマクリーニング処理の終了時点を精度よ く判定できるプラズマクリーニング装置に関する。 [0002]

【従来の技術】プラズマCVD装置は、超LSI等の製 造において、試料ウエハ表面に酸化膜や窒化膜などの薄 膜を成膜するのに用いられる。ところで、薄膜を成膜す る際には、試料ウエハ表面に薄膜が形成されると同時に チャンパの内壁やチャンパ内の構造物(シャワー電極や サセプタ)上にも不要付着物が堆積する。 とのため、何 枚もの試料の成膜を繰り返していると、例えば、累積的 に付着した不要付着物が内壁からフレーク状になって剥 がれ、ウエハ上に落下する。ウエハ上に不要付着物が落 下すると、薄膜の欠陥の原因となる。

【0003】そこで、このような問題点を解消するに は、チャンパの内壁等に堆積した不要付着物がある程度 30 堆積した時点で、これを除去する必要がある。その方法 の一つとして、プラズマクリーニングが従来より広く行 われている。

【0004】このプラズマクリーニングは、ウエハを取 り出した後の真空状態のチャンバ内に、フッ素系ガスの CF., C,F., C,F., NF,等と、酸素系ガスの Oz, NzO等からなる混合ガスを導入し、そとへ髙周波 等の電界を加えて放電を起とし、ブラズマ状態にする。 すると、プラズマで活性化したフッ素がチャンバ内壁等 に堆積した不要付着物と反応し、これをガス化してチャ ンバ内壁等から放出する。よって、このガスをチャンバ の排気系から排気すれば、チャンバ内の不要付着物を除 去できる。

【0005】なお、プラズマクリーニングが盛んに行わ れるようになる前は、チャンバを大気開放し、作業者が 手作業で不要付着物を剥がす作業をしていた。こういっ た手作業のクリーニングに比べて、プラズマクリーニン グではチャンパの大気開放や、内部ヒータの降温・再昇 温等の時間のかかる作業が不要になるので、表面に薄膜 を形成したウエハの生産性を大幅に向上できるメリット

【0006】しかるに、プラズマクリーニングでは、チャンパ内の汚れを直接観察できないので、チャンパ内を完全に清浄な状態にクリーニングできたか否かの判定が難しい。

【0007】 CCで、プラズマクリーニング終了時にチャンパ内の状態を常に一定の清浄な状態にできれば、成膜プロセスの再現性が確保される。そのため、安定した性能の製品を生産するには、プラズマクリーニング処理の終了時点を正確に判定することが特に重要である。

【0008】プラズマクリーニング処理の終了時点の判 10 断で最も単純な方法は、成膜時間に見合ったクリーニン グ時間を予め経験的に定めておき、その時間が経過した 段階でクリーニング処理を終了する方法である。

【0009】しかし、不要付着物の発生は成膜プロセスパラメータの変化で大きく変わったり、同一条件の成膜後のクリーニングでも、不要付着物とフッ素ガスとの反応の進み具合が違っていたりするため、予めプラズマの放電時間を定めてクリーニングを行ったとしても、チャンパを開けて観察してみたら不要付着物が完全に除去出来ずに残っているといった不具合を生じる。

【0010】また、逆に、クリーニング時間を長く取りすぎ、装置の稼働効率を悪くしたり、クリーニングに使用するフッ化ガスを無駄に消費したりする不具合も生じる。

【0011】そこで、ブラズマクリーニング処理の進行を何らかの手段により監視する方法が幾つか考えられている。従来のブラズマクリーニング処理の終了時点の検出方法の一例として、ブラズマ発光スペクトルの変化を観測する方法がある。この方法は、ブラズマクリーニングで不要付着物とファ化ガスが盛んに反応しているとき 30のブラズマの光と、不要付着物が除去されてファ化ガスだけで放電しているブラズマの光とでは、発光スペクトルの分布が異なるので、これを利用して、分光器でクリーニング中のブラズマの光のスペクトル分布を観測することにより終了時点を検出する手法を採用している。

【0012】との他に、特開昭63-129629号公報に記載されたチャンバ内の圧力変化を観測する方法がある。この方法は、プラズマクリーニング処理の際に不要付着物とフッ化ガスが盛んに反応している時のチャンバ内の圧力と、不要付着物が除去されてフッ化ガスだけ40で放電している時のチャンバ内の圧力が異なることを利用して、圧力制御手段(圧力計測手段を兼ねる)の出力を観測することによりクリーニングの終了時点を検出する手法を採用している。

【0013】以上の方法は、in-Situ、即ち、実際にクリーニングしている状態を「その場」でモニタし、クリーニング処理の終了時点を判定する方法であるが、これとは別の方法として、バーティクルカウンタ等のパーティクル計数手段を用い、チャンバからの排気ガス中の微粒子パーティクルを観測する方法がある。

【0014】CCで、パーティクルカウンタはレーザ光の散乱等を利用して気体中に含まれる微粒子パーティクルを計測するもので、最小0.2μm程度の微粒子の数を最高毎秒1000カウントまで計測できる性能の計数器が市販されている。

【0015】従来、このようなパーティクルカウンタは、成膜中もしくは成膜後にN,ガスでチャンバをパージする際の排気ガス中のパーティクルを計測し、カウント数の上昇具合からクリーニング時期を知るのに使われているが、クリーニングの終了時点を検証するのにも使われる。

【0016】その方法は、まず、予め定められた時間だけプラズマクリーニングを行い、その後、窒素パージして排気ガス中に含まれるパーティクル数をカウントし、その量が減少してあるレベル以下になると、クリーニング処理の終了と判定する一方、未だあるレベルまで減少していなければ、再度、時間を定めてプラズマクリーニングを行うという手法を採用している。

[0017]

0 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のような方法ではブラズマクリーニング処理の終了時点の 判定を正確に行うことは困難である。以下に従来技術の 原理を述べて、その問題点を説明する。

【0018】まず、発光スペクトルを観測する方法で は、覗き窓やサービスポートを通してプラズマの光を分 光器に入れると、ブラズマの光の波長に対応した発光ス ベクトルのピークが観測できる。プラズマクリーニング 処理の開始とともに不要付着物とフッ化ガスの反応によ って生じた物質の光により、スペクトル分布のある波長 で大きなピークが観測され、クリーニングが進行する と、このピークが減少してゆく。従って、このピークの 消滅をプラズマクリーニング処理の終了と判定する。 【0019】ところで、このような発光スペクトルを観 測する方法では、覗き窓やサービスポートを通してプラ ズマの光が分光器に入るため、観測できる範囲が限ら れ、死角ができる。プラズマクリーニング処理の終了時 点の検出では、チャンバ内壁やチャンバ内の複雑な構造 部分に付いた不要付着物まで完全に除去されたことを正 確に確認できることが求められるが、このような方法で は、チャンバ内の中心付近のプラズマの光ばかりを観測 することになる。

【0020】この結果、チャンバ内壁やチャンバ内の構造が複雑な部分での反応によるプラズマの光を観察することが困難であり、プラズマクリーニング処理の終了時点を見誤る事態が多発するという問題点がある。

【0021】チャンバ内の圧力変化を観測する方法としてば、例えば、コンダクタンスバルブの開き具合を一定にして、排気バルブのコンダクタンス (バルブの開き具合等)を固定し、一定量のガスを供給をした状態でプラ ズマクリーニング処理を実行し、チャンバの圧力変化を

圧力計で観察する方法と、チャンバの圧力が常に一定に なるように排気バルブのコンダクタンスをチャンパ内の 圧力変化に追従させて調整し、圧力制御する状態でプラ ズマクリーニング処理を実行し、排気バルブのコンダク タンスがどのように変化するかを観察する方法がある。 【0022】前者の圧力計で観察する方法では、プラズ マクリーニング処理を開始すると、チャンバ内のガスが プラズマとなり、チャンパ内壁等の不要付着物と反応 し、それをガス化することにより、チャンバ内の圧力値 が上昇する。圧力はプラズマと不要付着物との反応が盛 10 んになるのに合わせて暫く上昇し続け、やがて、チャン バ内の不要付着物が少なくなってきて、反応が下火にな ってくると、圧力値も下降し、プラズマクリーニング処 理が終了に向かうにつれて―定の値へと漸近する。そこ で、圧力値が所定の値に達した時をプラズマクリーニン グ処理の終了時点と判定する。

【0023】後者の排気バルブの開き具合を観察する方法でも、プラズマクリーニング処理を開始すると、チャンバ内のガスがプラズマとなり、チャンバ内壁等の不要付着物と反応してガス化し、チャンバ内の圧力が上昇す 20る。この圧力上昇は圧力計によりリアルタイムで検知され、チャンバ内圧を一定に保つように、排気バルブにフィードバックがかかるので、排気バルブの開き具合がだんだん大きくなり、反応の進行に合わせて開き具合が増加し、極大を経て、チャンバ内の不要付着物が少なくなってくるとある値へと減少する傾向を示す。従って、この時点をプラズマクリーニング処理の終了時点と判定する。

【0024】ところで、これらの方法における圧力値又はバルブの開き具合の増減の時間変化は、確かに、ブラズマクリーニング処理の終了時点を示唆する如く、時間がたつにつれて収束の傾向を観測できるが、同一条件の成膜とブラズマクリーニングの繰り返しにおいても収束時間にばらつきがあり、終了時点の判定にあまりよい再現性が見られない。そのために判定を誤り、クリーニング不足やオーバークリーニングになってしまう等、終了時点の判定が正確にできなかった。

【0025】その理由は、チャンバ内の不要付着物はプラズマクリーニング処理の際、フッ化ガスと反応してガス化すると同時に、もともと付着力が弱いために微粒子 40となってガスと一緒に排気される。従って、チャンバ内の圧力変化を観察する方法では、微粒子となって除去される分を無視しているため、この成分が多かったり、少なかったりすることに起因して、プラズマクリーニング処理の終了時点の判定が早すぎたり、遅すぎたりする問題点を生じる。なお、この問題点は次に説明するバーティクルを計数する方法でも発生する。

【0026】また、圧力計で圧力変化を観測する方法では、チャンバ内の圧力に比べて圧力の変化量が小さかったりするので、変化が測定しにくいという欠点もあっ

た。 このため、 量産装置で安定して使用するには不十分 であった。

【0027】チャンバからのパーティクルを計数する方法では、プラズマクリーニング処理後に、窒素パージしてパーティクルの数を計数し、更に、プラズマクリーニング処理を再行するといった操作を、場合によっては何回か繰り返さなくてはならず、特にクリーニングを正確に行おうとすると、クリーニング時間を短くして頻繁にパーティクルの数を計数するといった、非常に手間がかかる方法になる。逆に、手間を省くため、クリーニング時間を長めにすると、オーバークリーニングし勝ちになってしまう。何れにせよ、この方法でプラズマクリーニング処理の終了時点の検出を行うには、クリーニング時間の設定に特別な経験や勘が必要になってくる。

【0028】本発明は、このような現状に鑑みてなされたものであり、経験や勘に頼ることなく、プラズマクリーニング処理の終了時点を正確に判定することができるプラズマクリーニング装置を提供することを目的とする。

[0029]

30

【課題を解決するための手段】本発明のブラズマクリーニング装置は、ブラズマCVD装置の真空状態にあるチャンパ内にクリーニング用のガスを導入し、続いて、該ガスをプラズマ状態にし、該チャンパの内壁及び該チャンパ内の構造物に付着した不要付着物と反応させ、反応物をガス化して該チャンパから排気することによりブラズマCVD装置のクリーニングを行うブラズマクリーニング装置であって、反応物をガス化してなる排気ガスを該チャンパから排気する排気系にパーティクル計数手段を設け、ブラズマクリーニング時において、該バーティクル計数手段により該排気ガス中に含まれる微粒子パーティクルの数を計測し、計測値が所定の値に収束すると、その時点でブラズマクリーニング動作を停止させるように構成されており、そのことにより上記目的が達成される。

【0030】好ましくは、前記チャンバ内の圧力を定期的に計測することにより、該チャンバ内の圧力変化を検出する圧力変化検出手段を更に備え、プラズマクリーニング時の該チャンバ内の圧力が一定となり、且つ前記パーティクル計数手段の計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズマクリーニング動作を停止させるように構成する。

【0031】また、好ましくは、前記チャンバのビューポート等に設けた発光スペクトル分析器を更に備え、プラズマクリーニング時に該発光スペクトル分析器により発光スペクトル強度を計測し、該発光スペクトル強度が所定の値に収束し、且つ前記バーティクル計数手段の計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズマクリーニング助作を停止させるように構成する。

50 【0032】また、好ましくは、前記圧力変化検出手段

20

により検出される圧力変化量の時間積分値及び前記パー ティクル計数手段により計測されるパーティクル変化量 の時間積分値を求め、更にこれらの時間積分値に所定の 係数を乗ずる演算手段を備え、これらの時間積分値に所 定の係数を乗じた値の合算値が所定の値になると、その 時点でプラズマクリーニング動作を停止させるように構

【0033】また、好ましくは、前記発光スペクトル分 析器により検出される発光スペクトル強度の時間積分値 及び前記パーティクル計数手段により計測されるパーテ ィクル変化量の時間積分値を求め、更にこれらの時間積 分値に所定の係数を乗ずる演算手段を備え、これらの時 間積分値に所定の係数を乗じた値の合算値が所定の値に なると、その時点でプラズマクリーニング動作を停止さ せるように構成する。

【0034】また、好ましくは、前記排気系は前記チャ ンバの底面排気口から真下に真っ直ぐに伸ばした排気配 管を有し、該排気配管の途中であって、該チャンバの底・ 面から10~100mm離反した位置に前記パーティク ル計数手段のセンサ部を取り付ける構成とする。

【0035】また、好ましくは、前記プラズマCVD装 置の成膜時に前記パーティクル計数手段のセンサ部を5 0~200℃に加熱するように構成する。

【0036】以下に本発明の作用を説明する。

【0037】本発明のプラズマクリーニング装置は、プ ラズマクリーニング処理中の排気ガスに含まれるバーテ ィクル量をその場で計数する(in-Situモニタリ ングする) 構成をとるため、プラズマクリーニング処理 の終了時点を正確に判定することができる。

【0038】今少し具体的に説明すると、プラズマクリ ーニング処理中の排気ガスには不要付着物から生じたバ ーティクルが含まれており、排気パーティクル量が不要 付着物除去の目安となる。その量は排気系に取り付けた パーティクル計数手段(パーティクルカウンタ)でモニ タできる。このパーティクルの測定で、プラズマクリー ニング処理の進行に連れ、パーティクルのカウント量は 先ず増大し、ビークに達してから減少して行くので、そ れが所定の値以下になった時点をクリーニング終了時点 の判断材料とすることができるのである。

【0039】なお、この所定の値については、チャンバ 40 内の不要付着物が完全になくなり、清浄な状態になる と、パーティクルもなくなり、理想的には0になるはず であるが、実際にはパーティクルカウンタのノイズや、 取り付け位置に元からあるバックグラウンドのパーティ クルがあるため、完全にOにはならない。従って、この 点を考慮して所定の値を選ぶものとする。

【0040】また、チャンバ内の圧力を定期的に計測す ることにより、チャンバ内の圧力変化を検出する圧力変 化検出手段を更に備え、プラズマクリーニング時のチャ ンバ内の圧力が一定となり、且つパーティクル計数手段 50 【0047】また、圧力変化検出手段により検出される

の計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズマ クリーニング動作を停止させる構成によれば、プラズマ・ クリーニング処理の終了時点をより一層正確に判定する ことができる。

【0041】即ち、プラズマクリーニング処理中におい て、チャンバの内壁等に付着した不要付着物がプラズマ からのイオンやラジカルを受けて微粒子パーティクルを 発生する際に、不要付着物とフッ化ガスが反応し、不要 付着物がガス化してチャンバ内壁等から放出されるの で、このガス量をチャンバ内に取り付けた圧力変化検出 手段によって測定される圧力変化から測定する。同時 に、パーティクルカウンタがパーティクル量を測定す

【0042】このように、チャンパ内の圧力変化と、パ ーティクル量の両方をモニタする構成によれば、不要付 着物がガス化されて除去される分と、パーティクルとな って除去される分の双方の成分、即ち、除去される不要 付着物の全成分をモニタすることができる。

【0043】このとき、圧力変化とパーティクル量はプ ラズマクリーニング処理の進行に連れて減少するので、 圧力が一定の値となる条件と、パーティクル量が所定の 値に収束する条件を組み合わせてプラズマクリーニング 処理の終了時点を判定する。これにより、どちらか一方 の条件のみで終了時点を判定する場合に比べて、より正 確な終了判定ができる。

【0044】また、発光スペクトル分析器を更に備え、 プラズマクリーニング時に発光スペクトル分析器により 発光スペクトル強度を計測し、発光スペクトル強度が所 定の値に収束し、且つパーティクル計数手段の計測値が 所定の値に収束すると、その時点でプラズマクリーニン グ動作を停止させる構成によっても、プラズマクリーニ ング処理の終了時点をより一層正確に判定することがで

【0045】即ち、不要付着物がガス化した気体の発光 スペクトルに注目すれば、発光スペクトルの強度とガス 化した量との間に相関があるので、この発光スペクトル の強度を観察することで、不要付着物のガス化によるチ ャンバ内の圧力変化をモニタできる。同時にパーティク ルカウンタでパーティクル量を観察し、発光スペクトル 強度が所定の値に収束する条件とバーティクル量が所定 の値に収束する条件を組み合わせると、バーティクルに なる現象とガス化される現象の両方を総合したプラズマ クリーニング処理の終了時点の判定が可能になる。

【0046】但し、発光スペクトル観察の欠点である死 角ができないような構造にする。また、発光スペクトル 強度は受光器の感度により、発光が激しく光が強い時、 飽和して正確に強度が測れなかったりするので、その時 は、受光部を離したり、感度を下げたりするものとす る。

位置としては、上記の位置が好ましい。

圧力変化量の時間積分値及びパーティクル計数手段によ り計測されるパーティクル変化量の時間積分値を求め、 更にこれらの時間積分値に所定の係数を乗ずる演算手段 を備え、これらの時間積分値に所定の係数を乗じた値の 合算値が所定の値になると、その時点でプラズマクリー ニング動作を停止させる構成によれば、作業者の主観に よらない客観的でより安定なプラズマクリーニング処理 の終了時点の判定を正確に行える。

【0048】同様に、発光スペクトル分析器により検出 される発光スペクトル強度の時間積分値及びパーティク ル計数手段により計測されるパーティクル変化量の時間 積分値を求め、更にこれらの時間積分値に所定の係数を 乗ずる演算手段を備え、これらの時間積分値に所定の係 数を乗じた値の合算値が所定の値になると、その時点で プラズマクリーニング動作を停止させる構成によって も、作業者の主観によらない客観的でより安定なプラズ マクリーニング処理の終了時点の判定を正確に行える。 【0049】即ち、圧力変化又は発光スペクトル強度の 時間積分値はガス化して除去される不要付着物の量に比 例し、パーティクル量の時間積分値はパーティクル化し て除去される不要付着物の量に比例するので、各積分値 に比例係数を掛け、足し合わせることで、全不要付着物 の除去量を計算できる。

【0050】そして、この計算値を計算する毎に所定の 値と比較して、計算値が所定の値と等しくなったらプラ ズマクリーニング処理の終了時点と判定する。このとき 用いる所定の値については、過去の実験で既知となって いるチャンバ内に付着する全不要付着物量を用いる。そ とで、予め各種の成膜条件についての全不要付着物量を データベース化してメモリに取り込んでおき、プラズマ 30 クリーニング処理の開始前にその時の成膜条件に合うも のをメモリから呼び出して使用するものとする。

【0051】また、排気系はチャンバの底面排気口から 真下に真っ直ぐに伸ばした排気配管を有し、排気配管の 途中であって、チャンバの底面から10~100mm離 反した位置にパーティクル計数手段のセンサ部を取り付 ける構成によれば、パーティクルカウンタの測定感度を 向上でき、且つ正確に動作させることが可能になる。

【0052】即ち、パーティクルカウンタをチャンバか らあまりに離れた位置に取り付けると、チャンバからの 40 パーティクルが排気配管内に落下してカウントされない 不具合を生じたり、逆に、排気配管内に滞留したパーテ ィクルがカウントされることで、プラズマクリーニング 処理で発生したパーティクルの測定感度を悪くしてしま う一方、あまりにチャンバに近い位置にバーティクルカ ウンタを取り付けると、成膜時にパーティクルカウンタ 自体に不要付着物が付いてしまったり、プラズマの光が パーティクルカウンタに入り、正しく動作しなくなって しまうからである。

【0054】また、プラズマCVD装置の成膜時にパー ティクル計数手段のセンサ部を50~200℃に加熱す る構成によれば、成膜時にパーティクルカウンタのセン サ部に不要付着物が付きにくくなり、その分、精度のよ い測定が可能になるからである。

[0055]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面 に基づき具体的に説明する。

【0056】(実施形態1)図1は本発明プラズマクリ ーニング装置の実施形態 1 をこのプラズマクリーニング 装置を備えたプラズマCVD装置と共に示す。本実施形 態1のプラズマクリーニング装置は、プラズマCVD装 置の排気経路の途中に設けたパーティクルカウンタ14 の測定結果、即ちパーティクルのカウント数に基づきブ ラズマクリーニング処理の終了時点を判定する点に特徴 を有するものである。

【0057】まず、図1に基づきプラズマCVD装置の 概略構成について説明する。 チャンバ1の下部には試料 ウエハ2が載置されるサセプタ3が配置されており、そ の内部には試料ウエハ2の加熱を行うヒータ4が配置さ れている。

【0058】また、チャンバ1の上部にはサセプタ3と 対向してシャワー電極6が配置されている。シャワー電 極6にはRF電源8が接続され、RF電源8は制御部1 5によってオン・オフされる。

【0059】チャンバ1の下部には排気配管5が連通さ れ、真空ポンプ7によって10mTorr以下の真空に 排気される。排気配管5の途中にはパーティクルカウン タ14が設けられている。

【0060】加えて、チャンバ1の上端部には供給配管 9の一端部が連通され、供給配管9の他端側にはボンベ 10、11、12が接続されている。ボンベ10内には SiH,、NH,等の材料ガスが充填されており、供給配 管9を通してチャンパ1内にこの材料ガスが供給され る。なお、図では省略してあるが、ボンベ10は上記し たガス種ごとに複数本設けられており、チャンパ1内に はその混合ガスが供給される。また、ボンベ11内には プラズマクリーニング用のガスが充填され、ボンベ12 内にはN、ガスが充填されている。

【0061】次に、窒化膜を成膜する場合を例にとっ て、このプラズマCVD装置による試料ウエハ2に対す る薄膜の形成工程について説明する。まず、サセブタ3 上に試料ウエハ2を載置する。次に、真空ボンブ7によ り排気配管5を通してチャンバ1内を10mTorr以 下の真空に排気する。次に、ヒータ4により試料ウエハ 2を300~400℃程度に加熱する。

【0062】試料ウエハ2が加熱されたら、ボンベ10 から供給配管9とシャワー電極6を通してチャンバ1内 【0053】よって、パーティクルカウンタの取り付け 50 にSiH,、NH,等の混合ガスからなる材料ガスを供給

30

する。より具体的には、それぞれの材料ガスの流量を調整し、例えば、SiH。を30~80sccm、NH。を5~35sccm、N。を500~1000sccm程度流す。

【0063】そして、チャンパ1内の圧力が2~5Torrの範囲で設定した圧力になり、安定したら制御部15がRF電源8をオンする。これにより、シャワー電極6とサセプタ3との間に300~600W程度の高周波電界を印加し、チャンパ1内にプラズマを発生させる。すると、プラズマによりエネルギーを得た材料ガスが、加熱された試料ウエハ2上で反応して薄膜を生成する。所望の膜厚が得られたらRF電源8をオフする。一例として、700nmの膜厚を得るのに2分30秒ほど放電を加える。

【0064】次に、材料ガスの供給を停止し、真空ポンプ7によりチャンパ1内を10mTorr以下に真空引きする。そして、残留した材料ガスをチャンパ1内から完全に無くすために、N、ガスが充填されたボンベ12から供給配管9とシャワー電極6を通して、チャンパ1内にN、ガスを供給して窒素パージを行う。

【0065】そして、窒素パージ後、窒化膜が成膜された試料ウエハ2は不図示のロードロック室へ搬送ロボット等により搬出される。

【0066】以上が試料ウエハ2への成膜のプロセスであるが、このとき同時にチャンバ1の内壁やサセプタ3及びシャワー電極6の表面にも不要付着物が堆積してしまう。

【0067】との不要付着物はブラズマクリーニング処理によって除去される。以下にブラズマクリーニング処理の概略について説明する。

【0068】まず、サセプタ3上の試料ウエハ2を取り出し、窒素パージ後、チャンパ1内を10mTorr以下に真空引きする。次に、チャンパ1内にボンベ11からCェF。ガス及びOェガス等を混合したクリーニング用のガスを、供給配管9とシャワー電極6を通して、チャンパ1内に流量調整しながら供給する。一例として、CェF。を50~200sccm程度流し、チャンパ1内の圧力が0.1から5Torr程度になるように調整する。との時、サセプタ3はヒータ4で加熱していても、いなくてもよいが、200~400℃程度に加熱していた方が効率的にクリーニングできるので、実施する上で好ましいものになる。

【0069】また、プラズマクリーニング用のガスの流量は多いほど短時間でクリーニングできるが、チャンバ1内の圧力は成膜時の圧力より低い方がプラズマがチャンバ1内に拡がり易く、隅々までクリーニングできるので、排気のコンダクタンスを調整して適当に選択するものとする。

【0070】そして、チャンバ1内の圧力が安定した ら、RF電源8をオンしてシャワー電極6とサセプタ3 **1**2

との間に高周波電界を印加し、チャンバ1内にプラズマを発生させる。すると、プラズマにより活性化したフッ化ガスがチャンバ1の内壁等の不要付着物と反応してこれをガス化したり、パーティクル化して内壁等から放出させる。

【0071】そして、チャンバ1内の不要付着物が完全 に除去されたら、RF電源8をオフして放電を止め、プラズマクリーニング用のガスの供給を停止し、チャンバ1内を10mTorr以下に真空引きする。その後、残留したプラズマクリーニング用のガスを完全に無くすため、ボンベ12から供給配管9とシャワー電極6を通して、N.ガスをチャンバ1内に供給して窒素パージを行う。以上のプラズマクリーニング処理によりチャンバ1内は不要付着物が完全に除去され、清浄な状態に戻るので、再び、成膜プロセスを行うととが可能になる。

【0072】次に、上記のプラズマクリーニング処理における終了時点の判定方法について説明する。との判定方法に本実施形態1のプラズマクリーニング装置は特徴を有するものである。

20 【0073】プラズマクリーニング処理の開始とともに 高いエネルギーを得たラジカル又はイオンがチャンパ1 の内壁や構造物、即ちシャワー電極6やサセプタ3の表 面の不要付着物と反応し、ガス化すると共にパーティク ルが発生する。このパーティクルはチャンパ1内のガス の流れにより排気配管5から排気されるが、その途中に 取り付けたパーティクルカウンタ14によりその数がカ ウントされる。

【0074】 ことで、パーティクルカウンタ14の取り付け位置については注意が必要である。即ち、チャンバ1からあまりに離れた位置にパーティクルカウンタ14を取り付けると、チャンバ1からのパーティクルが排気配管5内に落下してカウントされない不具合を生じたり、逆に、排気配管5内に滞留したパーティクルがカウントされることで、プラズマクリーニング処理で発生したパーティクルの測定感度を悪くしてしまうからである。

【0075】一方、あまりにチャンパ1に近い位置にパーティクルカウンタ14を取り付けると、成膜時にパーティクルカウンタ14自体に不要付着物が付いてしまったり、プラズマの光がパーティクルカウンタ14に入り、正しく助作しなくなってしまうからである。

【0076】とのため、取り付け方法としては、チャンパ1の底面の排気口からの排気配管5は真下に曲がりなく伸ばし、その途中、即ち、チャンパ1の底面から10~100mm程度の位置にパーティクルカウンタ14のセンサ部を取り付けるのがよい。また、成膜時にパーティクルカウンタ14のセンサ部に不要付着物が付きにくくするため、センサ部を構成する投光部・受光部をヒータ4で50~200℃程度に加熱するとよい。

ら、RF電源8をオンしてシャワー電極6とサセプタ3 50 【0077】図2はプラズマクリーニング処理時のバー

ティクルのカウント数の変化の一例を示す。但し、縦軸はパーティクルのカウント数Nを表し、横軸は時間 t を表している。図2に示すように、本実施形態1では、時刻 t 1にRF電源8をオンして、ブラズマクリーニング処理を開始し、時刻 t 2にRF電源8をオフしてブラズマクリーニング処理を終了している。放電開始時刻 t 1 より前はパーティクルカウンタ14のカウント値はノイズレベルにある。これは、チャンパ1内や排気配管5に積もった不要付着物が自然に粉化して生じた微粒子によるもので、パーティクルカウンタ14の取り付けにもよ 10るが、毎秒0~2カウント程度の極少ない値である。

【0078】プラズマクリーニング処理を開始すると、クリーニングにより生じるパーティクルが排気されてきて、カウント数が増加し始め、やがてピークを迎える。このピークはチャンバ1の汚れ具合によって全く異なるが、例えば、放電開始より5~10分後に毎秒40から100カウントになる。クリーニングが進み、不要付着物が少なくなってくると、カウント数は徐々に減少して行き、不要付着物が全て除去されてチャンバ1内が清浄な状態になると最初のノイズレベルへ戻る。

【0079】本実施形態1では、このようなパーティクルカウント数の変化をモニタし、カウント数が最初のレベル(毎秒2カウント)まで減少したら、その時点をクリーニング処理の終了時点と判定し、RF電源8をオフする。

【0080】なお、ことでは、クリーニング放電開始前のパーティクル量のレベルを終了判定レベルとしているが、より厳しい条件の、完全なクリーニングが必要な場合は、予め、成膜開始前のチャンバ1内がクリーンな状態でプラズマクリーニング処理を行い、パーティクル量 30のレベルを求めておき、それを終了判定レベルとするとよい。これらの終了判定レベルは装置構造やパーティクルカウンタの機種、取り付けにより異なる。

【0081】なお、本実施形態1で例示した成膜・クリーニング条件の数値は、チャンバ1の構造等により変わるものであり、特に本発明を代表する数値ではない、本発明はこれらの数値が変わっても適用できるものである。更に、本実施形態1でプラズマクリーニング処理の終了時点の判定に使用する終了判定レベルについても、チャンバ1の構造、検出手段の種類、取り付け方や、ど 40の程度までのクリーニング度を必要とするかなど、使用環境・目的により大きく変える必要がある。

【0082】また、本実施形態1では、窒化膜の成膜の場合を示しているが、酸化膜、金属膜等についても、原理的にはプラズマクリーニング時の次の反応、即ち、不要付着物+クリーニング用のガス→排気ガス+パーティクルが、窒化膜の場合は、

(SiN)+(F)→(SiF+N₂)+(SiN) となるのが、酸化膜の場合は、

 $(SiO) + (F) \rightarrow (SiF + O_1) + (SiO_1)$

となり、金属膜の場合は、 (M) + (F) → (MxFy) + (M) 但し、

M:金属元素

x、y:任意の自然数

となるので、同様に適用できる。

【0083】(実施形態2)図3は本発明プラズマクリーニング装置の実施形態2を示す。本実施形態2のプラズマクリーニング装置は、パーティクルカウンタ14のカウント値と圧力計13の測定値に基づきプラズマクリーニング処理の終了時点を判定する構成をとり、圧力計13を付加した点のみが実施形態1のプラズマクリーニング装置とは異なっている。即ち、図2に示すように、本実施形態2では、チャンバ1の図上左側壁にチャンバ1内の圧力変化を測定する圧力計13を設けており、その他の構成は実施形態1と同様である。従って、実施形態1と対応する部分については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。

【0084】本実施形態2においても、実施形態1と同様に、プラズマクリーニング処理中に発生するパーティクルは排気配管5の途中に取り付けたパーティクルカウンタ14で測定する。加えて、本実施形態2では、それと同時にプラズマクリーニング処理中のチャンバ1内の圧力変化を圧力計13により測定している。

【0085】即ち、プラズマクリーニング処理の開始と共にプラズマの粒子によりチャンバ1の内壁等から弾き出された不要付着物のパーティクルが排気ガスとともに排出されるので、それをパーティクルカウンタ14によりモニタする。それと同時に、フッ化ガスと不要付着物の反応で生じた放出ガスによりチャンバ1内の圧力は上昇するので、これを圧力計13によりモニタする構成をとっている。

【0086】とのように、本実施形態2では、圧力計13とパーティクルカウンタ14を両方備えることで、圧力計13からは不要付着物のガス化した分を、パーティクルカウンタ14からは不要付着物のパーティクル化した分をモニタし、両方の測定結果を総合することで不要付着物の全ての除去具合をモニタし、プラズマクリーニング処理の終了時点を実施形態1よりも一層精度よく判定する構成をとっている。

【0087】以下にその詳細を図4を用いて説明する。但し、同図(a)は圧力計13の出力値、即ち、チャンパ1内の圧力Pの時間変化を表し、同図(b)はパーティクルカウンタ14の出力値、即ち、パーティクルのカウント数Nの時間変化を表わしており、これは図2のグラフと同様である。

【0088】同図(a)、(b)共に横軸は時間を表し、時刻t1にRF電源8をオンしてプラズマクリーニング処理を開始し、時刻t2にRF電源8をオフしてプラズマクリーニング処理を終了している。圧力Pはプラ

30

ズマクリーニング処理の開始前はクリーニング用のガス の供給量と排気コンダクタンスで決まる圧力P0(同図 (a) では0.6Torr) になっている。

【0089】プラズマクリーニング処理を開始すると、 クリーニング用のガスがプラズマ状態になることと、プ ラズマ化したフッ化ガスと不要付着物の反応で生じたガ スの放出により体積が増え、急に圧力が(同図(a)で は0.65 Torrに) 増加し、その後、フッ化ガスと 不要堆積物の反応で生じるガスの放出により更に体積が 増え、圧力も増え、緩やかに増加して、ビークを迎え (同図(a)では放電開始から9分後に0.67Tor r)、反応が下火になるにつれ、徐々に一定の圧力P1 (0.62Torr)へと減衰ずる。なお、P1は不要 付着物の無い状態で放電した時の圧力である。

【0090】そして、十分に圧力がP1に収束し、圧力 変化がなくなった時点(同図(a)では放電開始から2 6分後) にプラズマクリーニング処理の終了時点と判定 して放電を停止する。すると、プラズマが消滅して最初 の圧力POに戻る。ここで、圧力変化が無くなったかど うかは、圧力計13の出力が変化しなくなったかどうか 20 で判定する。本実施形態2では、出力分解能1mTor rの圧力計を用いて10秒間の圧力変化が±2mTor r以下であればガス化のクリーニング処理の終了時点と 判定した。カウント数Nについては実施形態1と同じ で、放電開始前はカウント値はノイズレベルにあり、プ ラズマクリーニング処理を開始するとクリーニングによ り微粒子パーティクルが生じてカウント数Nが増加し始 める。クリーニングが進み、不要付着物が少なくなって くるとカウント数Nは徐々に減少して行き、やがて、最 初のノイズレベルへ戻る。

【0091】圧力Pの変化もカウント数Nの変化も、一 般的にこの様な変化を辿るが、同じ条件で成膜とプラズ マクリーニングを繰り返していても、いつも図4のよう に同時に終了するのではなく、ある時は、不要付着物が **プラズマクリーニングでガス化するよりもパーティクル** になる量が多いため、圧力Pの変化が小さくカウント数 Nの変化が大きくなったり、逆に、ある時はガス化する 量の方が多いため、圧力Pの変化が大きく、カウント数 Nの変化が小さかったり、また、ある時はプラズマクリ ーニング処理の前半にガス化が進み、後からパーティク 40 ルがよく出て、圧力Pのピークがカウント数Nのピーク より時間的に先に起とったり、逆に、ある時は、後から ガス化が起こって圧力Pのピークがカウント数Nのピー クより後であったりする。

【0092】そのため、チャンバ1内の圧力Pを単独で モニタする従来の方法や、パーティクルのカウント数N を単独にモニタする実施形態1の手法では、およそのプ ラズマクリーニング処理の終了時点は判っても、確実な 終了時点の判定はできない。

【0093】本実施形態2は、これをより正確に終了判 50

定するために、圧力Pとカウント数Nの両方をモニタし て、圧力PはP1に、パーティクルカウント数Nはノイ ズレベルに十分に収束した時点でプラズマクリーニング

処理の終了時点と判定する。 との時点でチャンパ1内の 不要付着物は十分にガス化反応したか、表面から離脱し て、全て除去されている。

16

【0094】このため、本実施形態2のプラズマクリー ニング装置によってプラズマクリーニング処理の終了時 点を判定すれば、プラズマクリーニングにおいて不要付 着物のガス化と微粒子パーティクルになる反応がどの割 合で起こり、どの様に進行してもチャンパ1内がクリー ニングされたことを検知することができる。

【0095】(実施形態3)図5は本発明プラズマクリ ーニング装置の実施形態3を示す。本実施形態3のプラ ズマクリーニング装置は、実施形態2の圧力計13の代 わりに発光分析器19を用いてプラズマクリーニング処 理中の不要付着物のガス化をモニタし、プラズマクリー ニング処理の終了時点を判定する構成をとっており、そ の他の構成は実施形態2と同様である。従って、実施形 態2と対応する部分には同一の符号を付して重複する説 明は省略し、以下に異なる部分について説明する。

【0096】図5に示すように、チャンバ1の図上右側 壁には覗き窓18が付いており、この覗き窓18の外部 に発光分析器19が、チャンバ1内での発光を観察でき るように設置されている。

【0097】図6はプラズマクリーニング処理中の発光 をスペクトル分析した結果を示す。図6において、横軸 は光の波長を表し、縦軸はその波長の光の強度(縦軸W は単位のない相対量である)を表している。 プラズマの 光は全ての波長の光を含むのではなく、幾つかの特定の 波長の光で構成されており、例えば図6で波長λ1の光 が強い強度を持っているが、これはフッ化ガスと不要付 着物が反応して生じたSiFガスがプラズマからエネル ギーを受けて出す光である。同様にλ2はフッ化ガス自 体がプラズマからエネルギーを受けて出す光である。プ ラズマクリーニング処理の進行と共にチャンパ1内の不 要付着物が減少するので、λlのビークは小さくなり、 逆に、λ2のピークは大きくなって行く。

【0098】その様子を図7に示す。図7において、縦 軸Wは図6と同じく光の強度を示し、横軸 t は時間を表 している。図6のλ1とλ2の光に注目し、その強度W が時間と共にどうように変化するのかを示している。時 刻t1にプラズマクリーニング処理を開始すると、始め はフッ化ガスの多くが不要付着物と反応するので、λ1 の強度が強く、λ2の強度は弱い。反応が進み、不要付 着物が少なくなってくると、λ1が減少してきて、逆 に、λ2が増加してくる。チャンバ1内の不要付着物が 除去されて清浄な状態になると、λ1の光は0になり、 λ 2 は飽和する。

【0099】 ここで、プラズマクリーニング処理中の λ

1の光の強度をモニタすれば、不要付着物のガス化する 量をモニタすることになる。 λ 1 と λ 2 は相補的な関係 (λ 1 の光が減るとλ 2 の光が増える)にあるので、λ 2の光の強度をモニタしてもよい。λ1の光が0になっ たかどうかの判定は発光分析器19の出力で図6のよう に波長λ 1の強度が他の波長の強度に比べてピークにな っているかどうかで判定する。

【0100】本実施形態3の装置では、ピークの無い部 分での発光強度は5000以下だったのでこれを判定レ ベルとし、λ1の光の強度がそれ以下に下がった時をガ 10 ス化のプラズマクリーニング処理の終了時点と判定し た。

【0101】また、入2の光を使用する場合は、10秒 毎に発光強度の変化を観察し、増加量が20以下の時を ガス化のプラズマクリーニング処理の終了時点と判定し た。本実施形態2の装置で、不要付着物のガス化する量 をモニタし、実施例形態1のパーティクルカウンタ14 で、不要付着物のパーティクル化する量をモニタした結 果と合わせることで、全不要付着物の除去をモニタでき るので、実施形態2同様に正確なプラズマクリーニング 20 処理の終了時点の判定ができる。

【0102】(実施形態4)図8は本発明プラズマクリ ーニング装置の実施形態4を示す。本実施形態4のブラ ズマクリーニング装置は、圧力計13とパーティクルカ ウンタ14の他に、計算機16及びメモリ17を備え、 計算機16によりプラズマクリーニング処理の開始時点 からの圧力変化の積分値Σρと、プラズマクリーニング 処理の開始時点からのトータルのパーティクル量∑nを 演算し、これらの演算結果に基づきプラズマクリーニン グ処理の終了時点を判定する構成をとっている。以下に その詳細を説明する。なお、上記各実施形態と対応する 部分には同一の符号を付し重複する説明については省略 する。

【0103】図9 (a)、(b)は、図4 (a)、

(b)と同様に圧力計13とパーティクルカウンタ14 の出力の時間変化を示している。図9(a)中の斜線で 示した部分は、プラズマクリーニング処理の開始時点か らの圧力変化の積分値Σpを示している。

【0104】なお、圧力値のうち、P0からP1までの 変化、即ち、同図(a)中の点々で塗った部分について 40 は、プラズマが生じている間、クリーニング用のガス自 身のプラズマ化による圧力の増加分であり、常にオフセ ット値として加わってくる。これは、不要付着物とは関 係ない一定値である。この部分については予め不要付着 物のない状態で、同じ条件でプラズマクリーニングを行 い、その値P1を求めておき、それを実際に、不要付着 物がある場合の圧力値Pから減ずる (P-P1) という*

 $X 0 = \alpha \cdot \Sigma p 0 + \beta \cdot \Sigma n 0 = (A \cdot \Sigma P 0 + \Sigma n 0) \cdot \beta \cdots (6)$

未知のβを残した形になる。

*補正をする。この補正により不要付着物だけのガス化に よる圧力値の増減の変化を求めることができ、これを積 分したものがΣpになる。また、同図(b)中の斜線で 示した部分はプラズマクリーニング処理の開始時点から

のトータルのパーティクル量∑nを示している。

【0105】ととで、不要付着物のガス化した量Xpと Σρとの間にはほぼ比例関係が成り立ち、また、不要付 着物のパーティクル化した量XnとΣnとの間にもほぼ 比例関係がなりたつ。即ち、それぞれ比例係数をlpha、etaとすると、下記(1)式、(2)式の関係が成立する。

[0106] $Xp = \alpha \cdot \Sigma P \cdots (1)$

 $X n = \beta \cdot \Sigma n \cdots (2)$

ここで、比例係数α、βはチャンバ1の容積やプラズマ クリーニング処理時のガスの圧力、温度などにより異な る。そとで、予め使用するチャンバ1の使用するプラズ マクリーニング条件で成膜条件を同一にして成膜し (全 不要付着物量X0が同一の条件で)、クリーニングを行 う実験を数回行い、 Σ p、 Σ n を求め、それからα、 β を求める。

【0107】例えば、パーティクルがあまり出ない場合 は、Xp≒Xより、比例係数αは下記(3)式で表され る。

 $[0108] \alpha = X0/\Sigma P \cdots (3)$

また、圧力があまり変化しない場合は、Xn≒X0よ り、比例係数βは下記(4)式で表される。

 $[0109]\beta = X0/\Sigma n \cdots (4)$

この比例係数 α 、 β を初期値として、他の Σ p、 Σ nの 場合に合うように補正を加えて正確なα、βの値を求め る。実際にはX0は求めることが困難なので、比例係数 α 、 β は $A = \alpha/\beta$ のように比で求まる。

【0110】本実施形態4の装置では、A=15000 [個/Torr]の関係が得られた。この比例係数α、 βから、プラズマクリーニング処理の開始時点からの不 要付着物の除去された量Xが、下記(5)により求めら れる。

[0111]

 $X = Xp + Xn = \alpha \cdot \Sigma p + \beta \cdot \Sigma n \quad \cdots \quad (5)$ ここで、Xはプラズマクリーニング処理の開始時0で、 クリーニングの進行とともに増加し、最終的にある一定 値、即ち、全不要付着物量X0まで増加する。そこで、 過去の実験で既知の全不要付着物量の除去量を予定値X Oとして、計算値Xの変化をモニタし、XがXOになっ た時点をプラズマクリーニング処理の終了時点であると 判定する。

【0112】ここでもX0は絶対値で求まらず、下記 (6)式に示すように、

 Σ n 0はプラズマクリーニング処理の終了時の Σ p と Σ

判定方法は、上記実施形態 1~3の手法に比べて少し複雑であるが、不要付着物の除去量の増加そのものをモニタできるので、もし真空ポンプ7の異常やガス供給系の異常など、何らかの事情で作業者の気付かないうちにクリーニング反応が途中で止まってしまっても、完全に不要付着物が除去されたのか、それとも、まだ途中なのか区別することが可能になる。

19

【0114】本実施形態4では、このプラズマクリーニング処理の終了時点の判定方法を利用して、圧力計13の出力とパーティクルカウンタ14の出力の変化を計算 10機16に取り込み、プラズマクリーニング処理の終了時点を自動的に判定する構成をとっている。

【0115】図8において、制御部15からの指令でRF電源8がオンし、プラズマクリーニング処理が開始すると、同時に、制御部15は計算機16に指令を出し、時刻1に圧力計13で測定された圧力値P(t)とパーティクルカウンタ14で測定されたパーティクル量N(t)を計算機16へ取り込む。計算機16内ではこれら入力データを使って終了判定を行い、終了と判定したら制御部15へ終了信号を出す。

【0116】制御部15は終了信号が入ったらRF電源8へ指令を出して放電をオフし、ププラズマクリーニング処理を終了する。

【0117】メモリ17には予め、実験して求めた各種 の成膜条件でチャンパ1内に堆積する全不要付着物の除 去量の予定値XOと、やはり実験で求めた各種のプラズ マクリーニング条件での、クリーニング用のガス自身の プラズマ化による圧力のオフセット分P1と、圧力変化 と不要付着物量の比例係数数α、パーティクル量と不要 付着物量の比例係数βをデータとして記憶させておき、 計算機16が終了判定の計算をする際に適宜参照する。 【0118】計算機16は実際に行った成膜に対応する 不要付着物除去量の予定値XOと、これから行うクリー ニング条件に対応する圧力のオフセット分P1、比例係 数α、βをメモリ17から取り出す。計算機16はプラ ズマクリーニング処理の進行中、各時刻tの圧力値Pi = P(t)とパーティクル数Ni = N(t)をメモリ1 7へ格納すると同時に、リアルタイムでプラズマクリー ニング処理の開始時点からのP(t)とN(t)の積分 値 $\Sigma p = \Sigma P i$ (= $P 1 + P 2 + \dots + P i$) と $\Sigma n = \Sigma$ 40 Ni (= N1 + N2 + ··· + Ni) を計算し、Σρから不 要付着物のガス化した量の推定値 $Xp = \alpha \cdot \Sigma p$ を、 Σ nから不要付着物のパーティクルとなって排気された量 の推定値 $X n = \beta \cdot \Sigma n$ を計算する。 クリーニングで除 去された全不要付着物の推定値Xは、XpとXnの和と して計算できる。XとXOを比較してX=XOとなった 時点でチャンバ1内の不要付着物が全て除去されたと判 定し、プラズマクリーニング処理を終了する信号を制御 部15へ送る。

【0119】計算機16による上記の処理手順を図10

に基づき今少し具体的に説明する。計算機 16 は、プラズマクリーニング処理が開始されると、まず、ステップ S1 でメモリ 17 から上記のP1、 α 、 β 、X0 を読み出す。続いて、ステップ S2 で i=0 とする初期化を行う

20

【0120】次に、ステップS3でi=i+1にインクリメントする。続いて、ステップS4で、圧力計13及びパーティクルカウンタ14からのデータを取り込み、圧力値の補正を行う。続いて、ステップS5でプラズマクリーニング処理の開始時点からのデータの積算を行う。そして、ステップS6でデータ積算値を不要付着物の量に換算する。続いて、ステップS7で全不要付着物量を演算し、ステップS8でX≧X0を確認した時点で、プラズマクリーニング処理の終了時点であると判定し、この処理を終了する。

【0121】本実施形態4の手法は、圧力計13の代わりに、発光分析器19を使用する場合も、オフセット分P1が0になり、圧力値P(t)を特定波長の発光強度W(t)と読み替えれば、全く同様に使用することがで20、きる。

【0122】圧力計13の代わりに、発光分析器19を使用する場合については、図11のようになる。即ち、圧力P(t)のグラフが同図(a)に示す発光強度W(t)のグラフのようになり、オフセット分がなくなる点が異なるが、それ以外は同じで Σ_P と同様に ΣW を求めればよい。

[0123]

【発明の効果】以上の本発明プラズマクリーニング装置によれば、プラズマクリーニング処理中の排気ガスに含まれるパーティクル量をパーティクル計数手段によりその場で計数し、パーティクルのカウント値が所定の値に収束した時点でプラズマクリーニング処理の終了時点を正確に判定することができる。

【0124】また、特に請求項2記載のプラズマクリーニング装置によれば、チャンバ内の圧力を定期的に計測することにより、チャンバ内の圧力変化を検出する圧力変化検出手段を更に備え、プラズマクリーニング時のチャンバ内の圧力が一定となり、且つバーティクル計数手段の計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズマクリーニング動作を停止させる構成をとるので、プラズマクリーニング処理の終了時点をより一層正確に判定することができる。

【0125】また、特に請求項3記載のプラズマクリーニング装置によれば、発光スペクトル分析器を更に備え、プラズマクリーニング時に発光スペクトル分析器により発光スペクトル強度を計測し、発光スペクトル強度が所定の値に収束し、且つパーティクル計数手段の計測値が所定の値に収束すると、その時点でプラズマクリーニング動作を停止させる構成をとるので、プラズマクリ

ーニング処理の終了時点をより一層正確に判定すること ができる。

【0126】また、特に請求項4記載のプラズマクリーニング装置によれば、圧力変化検出手段により検出される圧力変化量の時間積分値及びパーティクル計数手段により計測されるパーティクル変化量の時間積分値を求め、更にこれらの時間積分値に所定の係数を乗ずる演算手段を備え、これらの時間積分値に所定の係数を乗じた値の合算値が所定の値になると、その時点でプラズマクリーニング動作を停止させる構成によれば、作業者の主10観によらない客観的でより安定なプラズマクリーニング処理の終了時点の判定を正確に行える。

【0127】また、特に請求項5記載のプラズマクリー ニング装置によれば、発光スペクトル分析器により検出 される発光スペクトル強度の時間積分値及びパーティク ル計数手段により計測されるパーティクル変化量の時間 積分値を求め、更にとれらの時間積分値に所定の係数を 乗ずる演算手段を備え、これらの時間積分値に所定の係 数を乗じた値の合算値が所定の値になると、その時点で プラズマクリーニング動作を停止させる構成をとるの で、作業者の主観によらない客観的でより安定なプラズ マクリーニング処理の終了時点の判定を正確に行える。 【0128】また、特に請求項6記載のプラズマクリー ニング装置によれば、排気系はチャンバの底面排気口か ら真下に真っ直ぐに伸ばした排気配管を有し、排気配管 の途中であって、チャンバの底面から10~100mm 離反した位置にパーティクル計数手段のセンサ部を取り 付ける構成をとるので、パーティクルカウンタの測定感 度を向上でき、且つ正確に動作させることが可能にな

【0129】また、特に請求項7記載のプラズマクリーニング装置によれば、プラズマCVD装置の成膜時にパーティクル計数手段のセンサ部を50~200℃に加熱する構成によれば、成膜時にパーティクルカウンタのセンサ部に不要付着物が付きにくくなり、その分、精度のよい測定が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1 】本発明プラズマクリーニング装置の実施形態 1 をプラズマCV D装置と共に示す模式図。

【図2】実施形態1のプラズマクリーニング装置に装置 40 されるパーティクルカウンタの出力の時間変化を示すグラフ。

【図3】本発明プラズマクリーニング装置の実施形態2

をプラズマCVD装置と共に示す模式図。

【図4】(a)は実施形態2のプラズマクリーニング装置に装置される圧力計の出力の時間変化を示すグラフ、

(b)はパーティクルカウンタの出力の時間変化を示す グラフ。

【図5】本発明プラズマクリーニング装置の実施形態3をプラズマCVD装置と共に示す模式図。

【図6】実施形態3のプラズマクリーニング装置に装置される発光分析器で観測したプラズマクリーニング中の発光スペクトルを示すグラフ。

【図7】実施形態3のプラズマクリーニング装置に装置される発光分析器で観測した特定波長の発光強度の時間変化を示すグラフ。

【図8】本発明プラズマクリーニング装置の実施形態4をプラズマCVD装置と共に示す模式図。

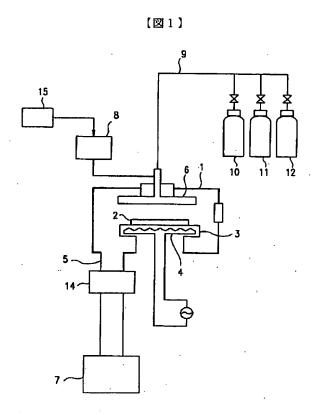
【図9】(a) は実施形態4のプラズマクリーニング装置に装置される圧力計の出力の時間変化を圧力変化の積分値 Σ p と共に示すグラフ、(b) はパーティクルカウンタの出力の時間変化をパーティクル量の積分値 Σ n と 20 共に示すグラフ。

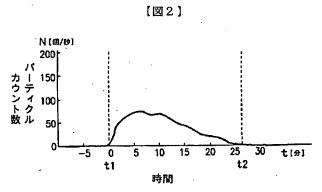
【図10】プラズマクリーニング処理の終了時点を判定する計算機の処理手順を示すフローチャート。

【図11】(a)は発光強度の時間変化を発光強度の積分値∑Wと共に示すグラフ、(b)はパーティクルカウンタの出力の時間変化をパーティクル量の積分値∑nと共に示すグラフ。

【符号の説明】

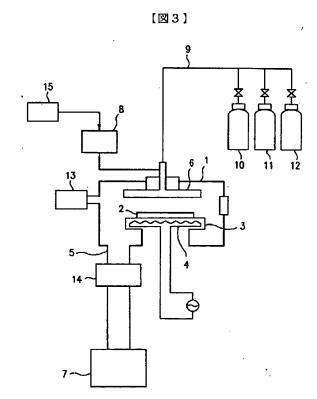
- 1 チャンバ
- 2 試料ウエハ
- 30 3 サセプタ
 - 4 ヒータ
 - 5 排気配管
 - 6 シャワー電極
 - 7 真空ポンプ
 - 8 RF電源
 - 9 供給配管
 - 10、11、12 ボンベ
 - 13 圧力計
 - 14 パーティクルカウンタ
- 0 15 制御部
 - 16 計算機
 - 17 メモリ
 - 19 発光分析器

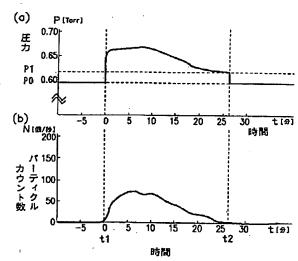




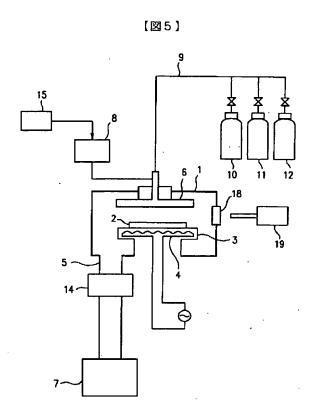
成膜畸条	†	クリーニ:	ング各件
基板溫度		基板温度	
RFパワー			
ガス圧力	4Torr	ガス圧力	
ガス種	SiH ₄ 70sccm	ガス種	C ₂ F ₈ 100sccm
	NH ₃ 25sccm		O ₂ 100sccm
	N ₂ 1000sccm		
放電時間	12.5%	放電時間	26分

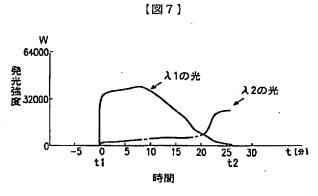
[図4]





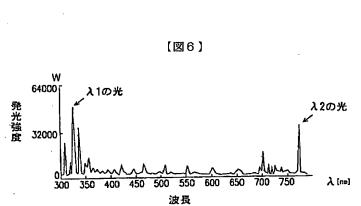
成膜時条件		クリーニ	ング条件
基板温度		姜板温度	
Rバワー	500W	RFパワー	
ガス圧力	4Torr	ガス圧力・	
ガス程	SiH ₄ 70sccm	ガス種	C ₂ F ₆ 100sccm
	NHs 25sccm		O ₂ 100sccm
	No 1000sccm		
放電時間	12.5%	放電時間	264

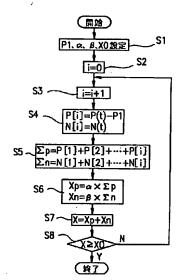


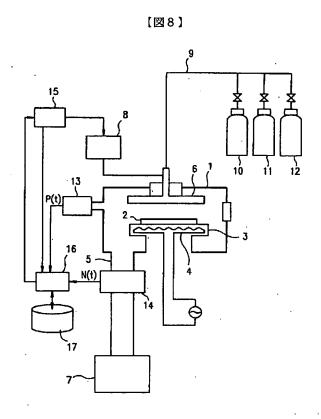


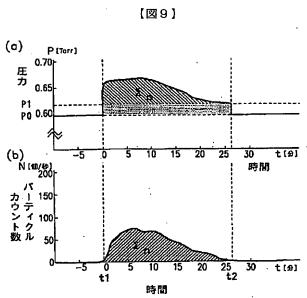
成膜時森作	‡	クリーニ:	ング条件
基板温度		基板温度	400°C
RFパワー	500W	RFパワー	400W
ガス圧力	4Torr	ガス圧力	0.6Torr
ガス種	SiH ₄ 70sccm	ガス種	C2Fs 100sccm
	NH ₃ 25sccm		0 ₂ 100sccm
	No 1000sccm		
放電時間	12.5 /)	放電時間	26分

【図10】



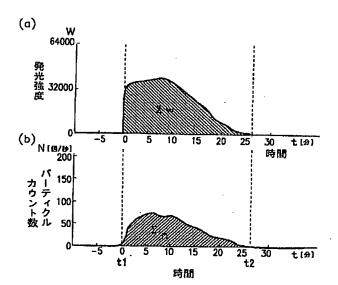






成膜畸条1	4	クリーニ	ング条件
基板温度	400℃	基板湯度	400℃
RFパワー		RFパワー	400W
ガス圧力	4Torr	ガス圧力	0.6Torr
ガス程	SiH ₄ 70sccm	ガス種	C ₂ F ₆ 100sccm
	NH ₃ 25sccm		0 ₂ 100sccm
	N ₂ 1000sccm		
放電時間	12.5 /)	放電時間	26 #)

【図11】



成群岛条件	‡	クリーニ:	ング条件
基板温度	400℃	基板温度	
	500W	RFパワー	
ガス圧力	4Torr	ガス圧力	0.6Torr
ガス種	SiH ₄ 70sccm	ガス種	C ₂ F ₆ 100sccm
	NH ₃ 25sccm		O ₂ 100sccm
	№ 1000sccm		
放鐵時間	12.55	放電時間	26%